

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012 年 12 月 27 日(27.12.2012)



(10) 国際公開番号
WO 2012/176407 A1

- (51) 国際特許分類:
H05B 33/26 (2006.01) *H01B 1/02* (2006.01)
C22C 5/06 (2006.01) *H01L 51/50* (2006.01)
C23C 14/34 (2006.01) *H05B 33/10* (2006.01)
G06F 3/041 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/003895
- (22) 国際出願日: 2012 年 6 月 14 日(14.06.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-140538 2011 年 6 月 24 日(24.06.2011) JP
特願 2012-004941 2012 年 1 月 13 日(13.01.2012) JP
特願 2012-120331 2012 年 5 月 26 日(26.05.2012) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱マテリアル株式会社(MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008117 東京都千代田区大手町 1 丁目 3 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 野中 莊平 (NONAKA, Sohei) [JP/JP]; 〒6691339 兵庫県三田市テクノパーク 1 2-6 三菱マテリアル株式会

社 三田工場内 Hyogo (JP). 小見山 昌三(KOMIYAMA, Shozo) [JP/JP]; 〒6691339 兵庫県三田市テクノパーク 1 2-6 三菱マテリアル株式会社 三田工場内 Hyogo (JP).

(74) 代理人: 高岡 亮一 (TAKAOKA, Ryoichi); 〒1710021 東京都豊島区西池袋 5-4-7 池袋トーセイビル 5 階 高岡 I P 特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

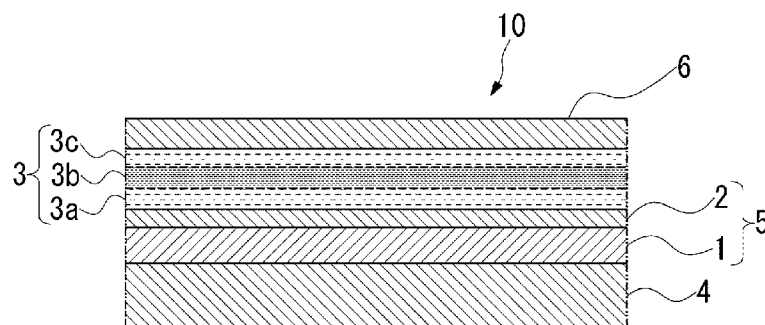
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

[続葉有]

(54) Title: CONDUCTIVE FILM AND METHOD FOR PRODUCING SAME, AND SPUTTERING TARGET USED FOR SAME

(54) 発明の名称: 導電性膜およびその製造方法並びにこれに用いるスパッタリングターゲット

[図1]



(57) Abstract: Provided are: a conductive film having low resistance and high reflectivity characteristics, and low surface roughness, and which combines high sulfidation resistance and heat resistance; a method for producing the conductive film; and a sputtering target used for the conductive film. The conductive film consists of a silver alloy having a component composition containing In and/or Sn at 0.1 to 1.5 at%, and further containing Sb at 0.1 to 3.5 at%, with the remainder comprising Ag and unavoidable impurities. The conductive film is suitable as a reflective electrode film for organic EL elements in which a transparent conductive film of an organic EL element is laminated on the surface, and an electroluminescent layer containing an organic EL layer is laminated thereabove.

(57) 要約: 低抵抗かつ高反射率の特性と共に表面粗さが小さく、高い耐硫化性及び耐熱性を兼ね備えた導電性膜およびその製造方法並びにこれに用いるスパッタリングターゲットを提供する。導電性膜が、In および Sn の少なくともいずれか: 0.1~1.5 原子%を含有し、さらに Sb を 0.1~3.5 原子%を含有し、残部が Ag および不可避不純物からなる成分組成を有した銀合金で構成されている。この導電性膜は、表面に有機 EL 素子の透明導電膜が積層され、さらにその上に有機 EL 層を含む電界発光層が積層される有機 EL 素子用の反射電極膜として好適である。

WO 2012/176407 A1



GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR,
NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))